

2T908A, KT908A, KT908B

Транзисторы кремниевые меза-планарные $n-p-n$ переключательные высокочастотные мощные

Предназначены для работы в ключевых стабилизаторах и преобразователях напряжения, импульсных модуляторах

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора без накидного фланца не более 22 г, с накидным фланцем не более 12 г

Пределевые эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при	
$T_n \leq 373$ К	
2T908A, KT908A при $R_{B3} = 10$ Ом	100 В
KT908B при $R_{B3} = 250$ Ом	60 В
Постоянное напряжение коллектор-база при $T_n \leq 373$ К	
2T908A	140 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	10 А
Постоянный ток базы	5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при	
$T_k \leq 323$ К	50 Вт
Температура перехода	423 К
Температура корпуса	398 К
Температура окружающей среды	От 213 до 398 К

Примечания I Постоянное напряжение коллектор-эмиттер и коллектор-база при $T_n = 373 - 423$ К снижается линейно на 10 % через каждые 10 К

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_k = 323 - 398$ К определяется по формуле

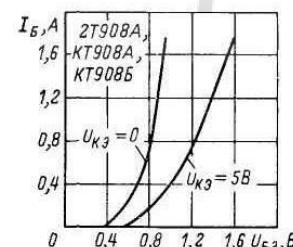
$$P_{K \max} = (T_n - T_k) / R_{T_{n-k}},$$

где $R_{T_{n-k}}$ – тепловое сопротивление переход-корпус, определяемое из области максимальных режимов (например, при $U_{K3} = 10$ В, $I_K = 5$ А $R_{T_{n-k}} = 2$ К/Вт)

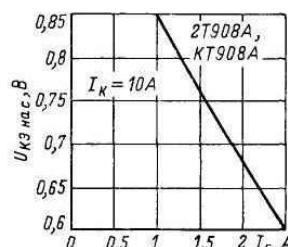
Не рекомендуется работа транзистора при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратными токами во всем диапазоне температур. При конструировании схем следует учитывать возможность самовозбуждения транзистора за счет паразитных связей.

2 Механические усилия на выводы транзистора не должны превышать 19,62 Н в осевом и 3,43 Н в перпендикулярном направлениях к оси вывода

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 6 мм от корпуса транзистора.



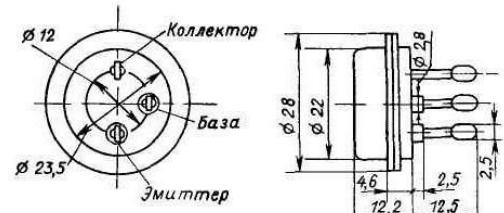
Входные характеристики



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока базы



Область максимальных режимов.



Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более:

2T908A, KT908A при $I_K = 10$ А, $I_B = 2$ А	1,5 В
2T908A при $I_K = 5$ А, $I_B = 1$ А	0,8 В
KT908B при $I_K = 4$ А, $I_B = 0,4$ А	1 В

Напряжение насыщения база-эмиттер не более

2T908A, KT908A при $I_K = 10$ А, $I_B = 2$ А	2,3 В
2T908A при $I_K = 5$ А, $I_B = 1$ А	1,6 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $T = 298$ К

2T908A, KT908A при $U_{K3} = 2$ В, $I_K = 10$ А	8–60
KT908B при $U_{K3} = 4$ В, $I_K = 4$ А не менее	20

Отиношение статического коэффициента передачи тока при $T_k = 398$ К к статическому коэффициенту передачи тока при $T = 298$ К, $U_{K3} = 2$ В, $I_k = 5$ А не более

2T908A	3
KT908A, KT908B	5

Время включения при $I_K = 5$ А, $I_B = 1$ А, $\tau_u = 10$ мкс

2T908A	0,1–0,3 мкс
типовое значение	0,2 мкс

Время рассасывания при $I_K = 5$ А, $I_B = 1$ А, $\tau_u = 10$ мкс

2T908A	0,6–2,6 мкс
типовое значение	2 мкс

Время спада при $I_K = 5$ А, $I_B = 1$ А, $\tau_u = 10$ мкс

2T908A	0,1–0,3 мкс
типовое значение	0,2 мкс

Модуль коэффициента передачи тока при $f = 10$ МГц,

$U_{K3} = 10$ В, $I_3 = 1$ А не менее	5
KT908A, KT908B	3

Емкость коллекторного перехода при $U_K = 10$ В, $f = 0,3$ МГц не более

700 пФ	
типовое значение	500 * пФ

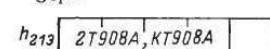
Обратный ток коллектора не более

при $T = 298$ К и $T = 213$ К.	
2T908A, KT908A при $R_{B3} = 10$ Ом, $U_{K3} = 100$ В	25 мА

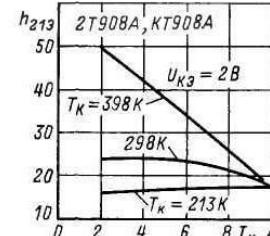
KT908B при $R_{B3} = 250$ Ом, $U_{K3} = 60$ В	50 мА
при $T = 398$ К 2T908A при $R_{B3} = 10$ Ом, $U_{K3} = 80$ В	50 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{B3} = 5$ В не более

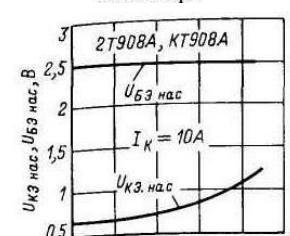
300 мА



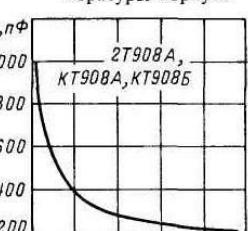
Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса



Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса



Зависимости напряжений насыщения коллектор-эмиттер и база-эмиттер от температуры корпуса.



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база.